

25Gbps InGaAs PD Chip $\phi 32\mu\text{m}$



产品描述

InGaAs 高速光探测器芯片

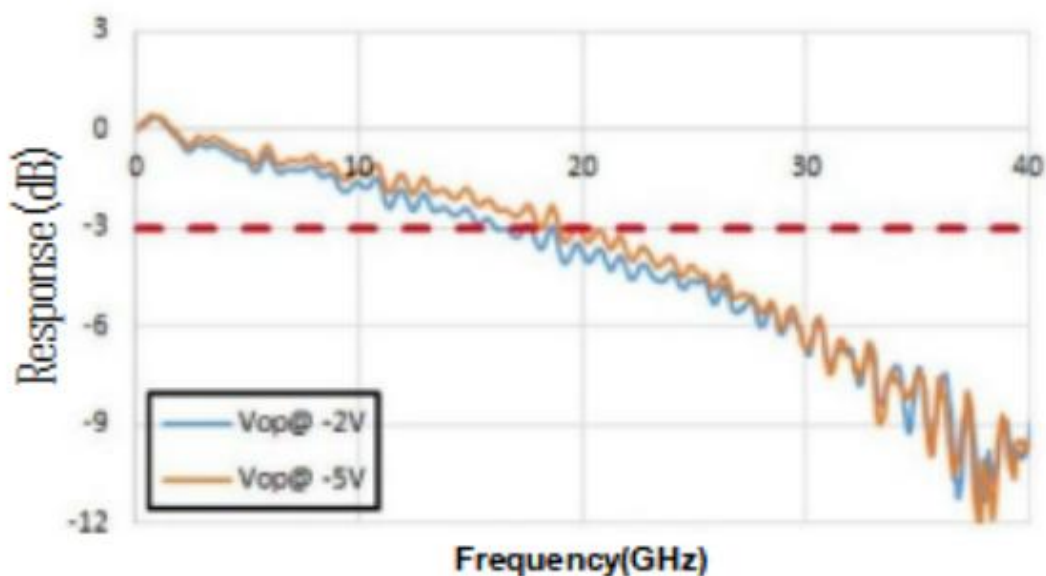
产品特点

数据速率高达 25GHz； $\phi 32\mu\text{m}$ 有效面积；高响应度；GSG 电极结构

应用领域

25Gbps 数据传输 | 第五代通信 | 25G EPON | 光纤数据通信

详细参数



规格 ($T_c=25^\circ\text{C}$, 单颗裸芯片)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ	900		1650	nm	
响应度	R	0.8	0.9		A/W	$\lambda=1310\text{-}1550\text{nm}$
暗电流	I_d		0.01	0.1	nA	$V_R=-5V$
电容	C		0.01	0.1	pF	$V_R=-2V, f=1\text{MHz}$
带宽	Bw		18		GHz	$V_R=-2V$ 3dB down, $R_L=50\Omega$
有效区直径	D		32		μm	